

Микросхемы интегральные 132РУ6А, 132РУ6Б, Б132РУ6Б-4

Функциональное назначение микросхемы

Оперативное запоминающее устройство (статическое) (16Кх1).

Конструктивное исполнение

Микросхемы 132РУ6А, 132РУ6Б изготавливаются в металлокерамических корпусах с золотым покрытием выводов 4153.20, Б132РУ6Б-4 в бескорпусном исполнении на общей пластине.

Нумерация, обозначение и назначение выводов микросхемы

Номер вывода микросхем 132РУ6А, 132РУ6Б, (контактной площадки микросхем Б132РУ6Б-4)	Обозначение	Наименование вывода
1 (1)	A3	Вход адресный строки
2 (2)	A4	Вход адресный строки
3 (3)	A5	Вход адресный строки
4 (4)	A6	Вход адресный строки
5 (5)	A7	Вход адресный столбца
6 (6)	A8	Вход адресный столбца
7 (7)	A9	Вход адресный столбца
8 (8)	DO	Выход информационный
9 (9)	\overline{WR}/RD	Вход сигнала записи/считывания
10 (10)	0V	Общий вывод
11 (11)	\overline{CE}	Вход сигнала разрешения
12 (12)	DI	Вход информационный
13 (13)	A10	Вход адресный столбца
14 (14)	A11	Вход адресный столбца
15 (15)	A12	Вход адресный столбца
16 (16)	A13	Вход адресный столбца
17 (17)	A0	Вход адресный строки
18 (18)	A1	Вход адресный строки
19 (19)	A2	Вход адресный строки
20 (20)	U	Вывод питания от источника напряжения

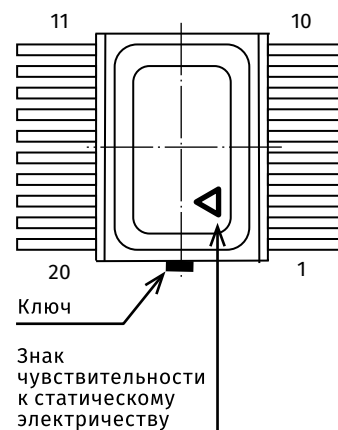
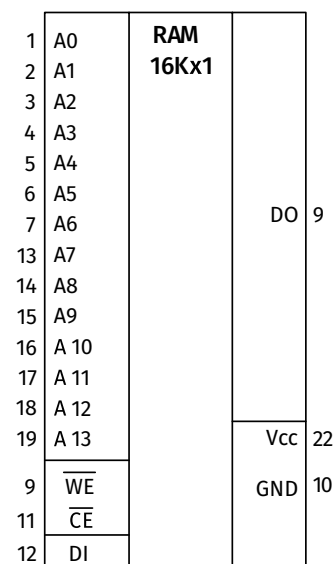


Схема расположения выводов



Условное графическое обозначение

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Температура среды, °С
		132РУ6А		132РУ6Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
1 Входное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC} = (4,5 - 5,5)$ В	U_{IL}	–	0,8 ¹⁾	–	0,8 ¹⁾	25 ±10 -60 – 85
2 Входное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC} = (4,5 - 5,5)$ В	U_{IH}	2,2 ¹⁾	–	2,2 ¹⁾	–	25 ±10 -60 – 85
3 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC} \leq 5,5$ В, $I_{OL} \leq 5$ мА	U_{OL}	–	0,4	–	0,4 ²⁾	25 ±10 -60 – 85
4 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC} \geq 4,5$ В, $I_{OH} \leq 2$ мА	U_{OH}	2,4	–	2,4 ²⁾	–	25 ±10 -60 – 85
5 Ток потребления в режиме хранения, мА при $U_{CC} \leq 5,5$ В, $U_{CEH} = U_{CC}$	I_{CCS1}	–	20	–	20 ²⁾	25 ±10 -60 – 85
6 Ток потребления в режиме хранения (микро- мощный режим), мА при $U_{CC} = 0$ В, $U_{CEH} = 5,5$ В	I_{CCS2}	–	2	–	–	25 ±10 -60 – 85
7 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА, при $U_{CC} \leq 5,5$ В, $U_{IL} = 0$ В и $U_{IH} = U_{CC}$	I_{LIL}, I_{LIH}	–	10	–	10 ²⁾	25 ±10 -60 – 85
8 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА при $U_{CC} \leq 5,5$ В, $U_{OZL} = 0$ В и $U_{OZH} = U_{CC}$	I_{OZL}, I_{OZH}	–	50	–	50 ²⁾	25 ±10 -60 – 85
9 Динамический ток потребления, мА при $U_{CC} \leq 5,5$ В, $t_{W(C)} \geq 100$ нс	I_{CCO}	–	75	–	75	25 ±10 -60 – 85
10 Время выборки разрешения, нс при $U_{CC} \geq 4,5$ В и $C_L \leq 42$ пФ для 132РУ6А $t_{W(C)} \geq 100$ нс ³⁾ для 132РУ6Б $t_{W(C)} \geq 140$ нс ³⁾	$t_{(CE)}$	–	55	–	70 ³⁾	25 ±10 -60 – 85
11 Время цикла записи, нс при $U_{CC} \geq 4,5$ В и $C_L \leq 42$ пФ для 132РУ6А $t_{W(C)} \geq 100$ нс ³⁾ для 132РУ6Б $t_{W(C)} \geq 140$ нс ³⁾	$t_{CY(WR)}$	85	–	120 ³⁾	–	25 ±10 -60 – 85
12 Время цикла считывания, нс при $U_{CC} \geq 4,5$ В и $C_L \leq 42$ пФ для 132РУ6А $t_{W(C)} \geq 100$ нс ³⁾ для 132РУ6Б $t_{W(C)} \geq 140$ нс ³⁾	$t_{CY(RD)}$	85	–	120 ³⁾	–	25 ±10 -60 – 85
13 Время установления сигнала разрешения после сигнала адреса, нс	$t_{SU(A-CE)}$	0	–	0	–	25 ±10 -60 – 85
14 Время удержания сигнала адреса после сиг- нала разрешения, нс	$t_{H(CEL-A)}$	25	–	40	–	25 ±10 -60 – 85
15 Время удержания сигнала записи после сиг- нала разрешения, нс	$t_{H(CEL-WR)}$	25	–	40	–	25 ±10 -60 – 85
16 Длительность интервала между сигналами разрешения, нс	$t_{W(CEH)}$	30	–	50	–	25 ±10 -60 – 85
17 Время установления сигнала разрешения после записи, нс	$t_{SU(WRL-CE)}$	0	–	0	–	25 ±10 -60 – 85
18 Входная емкость, пФ	C_I	–	9	–	9	25 ±10
	C_{ICE}	–	12	–	12	
19 Выходная емкость, пФ	C_O	–	12	–	12	25 ±10
¹⁾ С учетом всех видов помех.						
²⁾ В том числе и для микросхем Б132РУ6Б-4 в нормальных климатических условиях.						
³⁾ $t_{W(C)} = [t_{CY(RD)}(t_{CY(WR)})] + t_{HLCE} + t_{LHCE} = t_{ACE} + t_{W(CEH)} + t_{HLCE} + t_{LHCE}$.						
Примечание – Параметры $U_{IH}, U_{IL}, t_{SU(A-CE)}, t_{H(CEL-A)}, t_{H(CEL-WR)}, t_{W(CEH)}, t_{SU(WRL-CE)}, t_{CY(WR)}, t_{CY(RD)}$ являются режимными, их значения проверяются косвенно при проверке времени выборки разрешения.						

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Параметр	Ед. изм.	Предельно допустимый
Напряжение питания	В	4,5 – 5,5
Рабочая температура среды	°С	от -60 до +85
Предельная рабочая температура среды	°С	от -60 до +150